

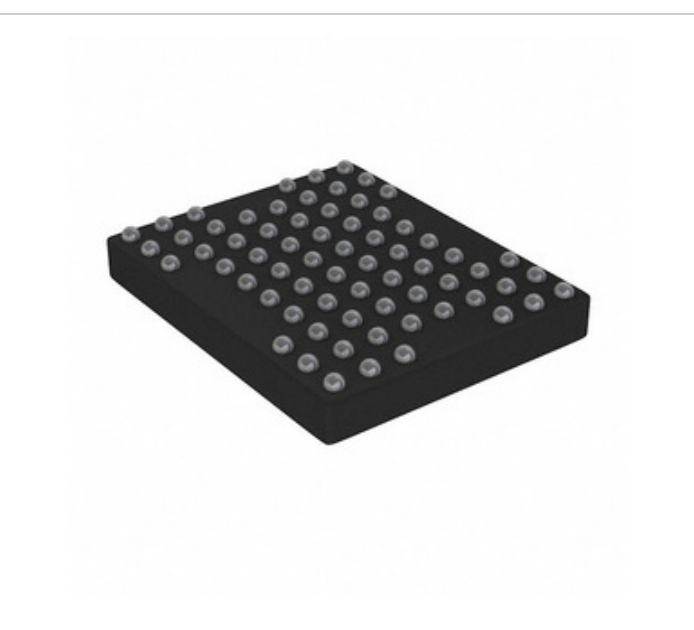
TOSHIBA
Leading Innovation >>>

Toshiba Memory America, Inc.

TC58NYG2S0HBAI6

លេខផ្នែក:
ក្រុមហ៊ុនផលិត / ម៉ាក:
ការពិពណ៌នាពីផលិតផល
តារាងទិន្នន័យ:
ស្ថានភាព RoHs
លក្ខខណ្ឌស្តុក
នាវាពី
ផ្លូវដឹកជញ្ជូន

TC58NYG2S0HBAI6
Toshiba Memory America, Inc.
IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA
 TC58NYG2S0HBAI6.pdf
 ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS
16396 pcs stock
ហ្យុងកុង
DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS



សំណូមពរសម្រាប់សម្រង់

រូបភាពអាចជាតំណាង។
សូមមើលលក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល។

លក្ខណៈពិសេសរបស់ TC58NYG2S0HBAI6

លេខផ្នែក	TC58NYG2S0HBAI6
ក្រុមហ៊ុនផលិត	Toshiba Memory America, Inc.
ការពិពណ៌នា	IC FLASH 4G PARALLEL 67VFBGA
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	ដឹកនាំដោយឥតគិតថ្លៃ / RoHS
បរិមាណដែលអាចរកបាន	16396 pcs
សន្លឹកទិន្នន័យ	TC58NYG2S0HBAI6.pdf
សរសេរពេលវេលាវដ្ត - ពាក្យទំព័រ	25ns
តង់ស្យុង - ផ្គត់ផ្គង់	1.7 V ~ 1.95 V
បច្ចេកវិទ្យា	FLASH - NAND (SLC)
កញ្ចប់ឧបករណ៍ផ្គត់ផ្គង់	67-VFBGA (6.5x8)
សេរី	-
ការដេចខ្ទប់	Tray
កញ្ចប់ / សំណុំរៀង	67-VFBGA
លេខ្នោះដីទៀត	TC58NYG2S0HBAI6JDH TC58NYG2S0HBAI6YCL
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ	-40°C ~ 85°C (TA)
ប្រភេទម៉ោង	Surface Mount
កម្រិតរស្មីសំណើម (MSL)	3 (168 Hours)
ប្រភេទអង្គចងចាំ	Non-Volatile
ទំហំអង្គចងចាំ	4Gb (512M x 8)
ចំណុចសតិអង្គចងចាំ	Parallel
ទ្រង់ទ្រាយអង្គចងចាំ	FLASH
ស្ថានភាពស្ថានភាពឥតបានការ / ស្ថានភាព ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ការពិពណ៌នាលម្អិត	FLASH - NAND (SLC) Memory IC 4Gb (512M x 8) Parallel 25ns 67-VFBGA (6.5x8)
ពេលវេលាចូលប្រើ	25ns

ស្លាកដែលទាក់ទង

Toshiba Memory America, Inc. TC58NYG2S0HBAI6	អ្នកចែកចាយ TC58NYG2S0HBAI6	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ TC58NYG2S0HBAI6
តម្លៃ TC58NYG2S0HBAI6	TC58NYG2S0HBAI6 រូបភាព	រូបភាព TC58NYG2S0HBAI6
TC58NYG2S0HBAI6 PDF Datasheet	TC58NYG2S0HBAI6 ទាញយកទិន្នន័យ	TC58NYG2S0HBAI6 Datasheet
ភាគហ៊ុន TC58NYG2S0HBAI6	ទិញ TC58NYG2S0HBAI6	ទិញ Toshiba Memory America, Inc. TC58NYG2S0HBAI6
Toshiba Memory America, Inc. TC58NYG2S0HBAI6	អ្នកផ្គត់ផ្គង់ Toshiba Memory America, Inc.	អ្នកចែកចាយ Toshiba Memory America, Inc.
Toshiba Memory America, Inc. TC58NYG2S0HBAI6		

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ

<p>TC595002ECBTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: Micrel / Microchip Technology ការពិពណ៌នា: IC REG LINEAR -5V 100MA SOT23-3 នៅក្នុងស្តុក: 112072 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>TC58NYG2S0HBAI4 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Toshiba Memory America, Inc. ការពិពណ៌នា: 4GB SLC NAND 24NM BGA 9X11 1.8V នៅក្នុងស្តុក: 21313 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>TC59 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Cornell Dubilier Electronics ការពិពណ៌នា: CAP ALUM 50UF 250V AXIAL នៅក្នុងស្តុក: 5581 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>TC594 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Cornell Dubilier Electronics ការពិពណ៌នា: CAP ALUM 200UF 300V AXIAL នៅក្នុងស្តុក: 3509 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>TC593 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Cornell Dubilier Electronics ការពិពណ៌នា: CAP ALUM 150UF 300V AXIAL នៅក្នុងស្តុក: 6793 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>TC58NVG2S0HTA10 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Toshiba Memory America, Inc. ការពិពណ៌នា: IC FLASH 4G PARALLEL 48TSOP I នៅក្នុងស្តុក: 18769 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>TC58NVG3S0FTA00 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Toshiba Memory America, Inc. ការពិពណ៌នា: IC FLASH 8G PARALLEL 48TSOP I នៅក្នុងស្តុក: 5537 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>TC593002ECBTR ក្រុមហ៊ុនផលិត: Micrel / Microchip Technology ការពិពណ៌នា: IC REG LINEAR -3V 80MA SOT23-3 នៅក្នុងស្តុក: 129044 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>TC58NYG0S3HBAI6 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Toshiba Memory America, Inc. ការពិពណ៌នា: IC FLASH 1G PARALLEL 67VFBGA នៅក្នុងស្តុក: 27472 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>TC59000001 ក្រុមហ៊ុនផលិត: TXC Corporation ការពិពណ៌នា: OSC MEMS 59MHZ 3.3V SMD នៅក្នុងស្តុក: 6102 pcs</p> <p>RFQ</p>
<p>TC58NYG1S3HBAI6 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Toshiba Memory America, Inc. ការពិពណ៌នា: IC FLASH 2G PARALLEL 67VFBGA នៅក្នុងស្តុក: 24105 pcs</p> <p>RFQ</p>	<p>TC58NYG1S3HBAI4 ក្រុមហ៊ុនផលិត: Toshiba Memory America, Inc. ការពិពណ៌នា: 2G NAND SLC 24NM BGA នៅក្នុងស្តុក: 24543 pcs</p> <p>RFQ</p>